



컨퍼런스 일정 6.30^{WED}

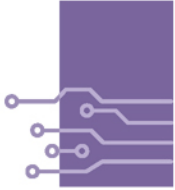
시간	주요 내용	발표자	장소
10:00-17:00	참가자 등록 (장소: 컨벤션센터 2층 로비)		
11:00	컨퍼런스 시작		
Opening & Plenary Session			좌장 : 이원재(동의대학교)
11:00 - 11:10	개회	SiC ² 조직위원장	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
11:10 - 11:50	[Plenary] Current status of SiC wafer manufacturing for power device application and its key challenges	Noboru OHTANI Kwansei Gakuin Univ. Japan	
11:50 - 12:20	[Invited] SiC bulk growth, wafering and epitaxy : Where we are and what we are looking for	Gilyoung CHUNG SK Siltron, U.S.A.	
12:20 - 13:20	중식 (썬큰 가든 & 가든 테라스)		
Oral Session - SiC Materials & Defect Analysis			좌장 : 정성민(한국세라믹기술원)
13:20 - 13:50	[Invited] 단결정 기판의 래핑 공정에서 그루브 밀도가 연마 특성에 미치는 영향	김형재 한국생산기술연구원	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
13:50 - 14:10	고품질 SiC 단결정 성장을 위한 용액성장 기술 개발	신윤지 한국세라믹기술원	
14:10 - 14:30	단결정 결함분석을 위한 포항가속기연구소 회절 영상기법 개발	김종현 포항가속기연구소	
14:30 - 14:50	이미지 분석 소프트웨어를 활용한 SiC 단결정 기판의 극성표면 특성의 정량적 분석	김정곤 웨이퍼마스터스	
Industry Session			좌장 : 김남균(한국전기연구원)
14:50~15:50	산업체 발표	사전 신청 기업	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
15:50~16:10	휴식 & 전시부스 참관		
16:10~17:00	● 한국전기전자재료학회 하계학술대회 특별강연 반도체 산업 최근 동향과 차세대 지능형 반도체	김형준 차세대지능형반도체사업단	포레스트홀 & zoom (컨벤션센터 2층)
17:00~17:10	휴식 & 전시부스 참관		
Poster Session			좌장 : 강인호(한국전기연구원)
17:10~18:00	포스터 논문 발표 (한국전기전자재료학회 하계학술대회 포스터세션과 통합하여 개최)	논문 번호 PB01 ~ PB33	로비
19:00-21:00	SiC인의 밤 - 만찬 및 경품 추첨 가든 테라스 (COVID-19 대응 준칙에 따라 장소 및 개최 여부의 변동 가능성이 있음)		



컨퍼런스 일정 7.1^{THU}

Conference Schedule

시간	주요 내용	발표자	장소
9:00-12:00	참가자 등록 (장소:컨벤션센터 2층 로비)		
9:30	컨퍼런스 시작		
Plenary Session			좌장 : 구상모(광운대학교)
9:30 - 10:40	[Plenary] The Road Ahead for SiC - Beyond 2020	Anant AGARWAL The Ohio State Univ. U.S.A.	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
10:40 - 11:00	휴식 & 전시부스 참관		
Oral Session - SiC Devices			좌장 : 김형우(한국전기연구원)
11:00 - 11:30	[Invited] Review of SiC Technology Development Status	박경석 On Semiconductor	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
11:30 - 11:50	탄화규소 금속-산화막-반도체 커패시터의 계면 특성에 대한 고온 산화 및 질화처리 효과	문정현 한국전기연구원	
11:50 - 12:10	초박형 4H-SiC junction Barrier Schottky diode의 전기적 특성에 관한 연구	김기현 에스파워테크닉스	
12:10 - 12:30	SiC P-Shielding Trench Gate MOSFET의 고온 역바이어스(HTRB) 시험 결과 및 전기적 특성변화에 관한 연구	서정운 파워큐브세미	
12:30 - 13:30	중식 (썬큰 가든 & 가든 테라스)		
Oral Session - Power Modules and Packaging			좌장 : 배현철(한국전자통신연구원)
13:30 - 14:00	[Invited] SiC 파워모듈용 가압형 Ag 소결 접합 기술 연구	홍경국 현대자동차	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
14:00 - 14:20	패키지 내부 구조 피로 개선을 위한 신개념의 양면 방열기판 패키지 구조	최윤화 제엠제코	
14:20 - 14:40	EV 파워 모듈용 고방열 sintering 소재 무가압/가압 접합 및 모듈 적용	배현철 한국전자통신연구원	
14:40 - 15:00	Chip Packaging Interaction for SiC Schottky Barrier Diode	장성욱 동의대학교	
Closing			
15:00 - 15:15	시상 및 폐회	SiC ² 조직위원장	오디토리움 (컨벤션센터 1층)
컨퍼런스 종료			



포스터 발표 논문 01-18

발표번호	제목	발표자	발표자 소속
PB-01	전자소자의 PN 접합 프로파일과 미세구조 분석	박윤창	나노종합기술원
PB-02	Structural and Spectroscopic Property of SiC By-products in Chemical Vapor Deposition	김슬기	한국세라믹기술원
PB-03	Deep Level Defect Transient Analysis of 4H-SiC MPS Devices	변동욱	광운대학교
PB-04	흑연접합제 유래에 따른 SiC-흑연 접합특성 평가	정성민	한국세라믹기술원
PB-05	Numerical analysis of the Helmholtz coil's effects on the performance of SiC crystal growth from melt	Minh-tan HA	한국세라믹기술원
PB-06	Defect Reduction in SiC Single Crystal During Solution Growth Process Under Low Pressure Condition	유용재	한국세라믹기술원
PB-07	고순도 β -SiC 분말을 사용하여 성장된 반절연 SiC 단결정	김태희	KC industrial
PB-08	고순도 β -SiC 분말을 사용하여 성장된 4 inch N-type SiC 단결정	김태희	KC industrial
PB-09	4성분계 조성을 이용한 고품질 SiC 단결정 성장	이승준	동의대학교
PB-10	CVD-SiC 리사이클링 소재를 원료로 적용한 SiC 단결정 성장	김용현	한국세라믹기술원
PB-11	PVT 방법에 의한 링 모양의 SiC 단결정 성장	제태완	동의대학교
PB-12	α -SiC 분말과 β -SiC 분말을 혼용하여 성장된 2인치 반절연 SiC 단결정	이채영	KCindustrial
PB-13	4H-SiC MPS Diode의 전기적 특성에 관한 연구	윤승복	(주)에스파워테크닉스
PB-14	3.3kV 고전압 4H-SiC 파워반도체 구현을 위한 FLR 이온주입 최적화 모델링	강예환	(주)에스파워테크닉스
PB-15	3.3 kV급 고전압 4H-SiC 파워반도체 구현을 위한 FLR 구조 모델링 최적화	박현	(주)에스파워테크닉스
PB-16	4H-SiC 디스크리트 MOSFET의 파워사이클링 가속 수명 시험	김미진	부산대학교
PB-17	Trench 구조의 Floating Field Ring을 삽입한 고내압 저면적 특성을 갖는 SiC Edge Termination에 관한 연구	서정윤	파워큐브세미(주)
PB-18	TEOS를 이용한 SiC 기반 Trench 구조에서의 절연체 특성 연구	성민제	포항공과대학교



포스터 발표 논문 19-33

Poster Session List

PB-19	Fabrication and Evaluation of 4H-SiC Double Trench MOSFETs on 6-inch Wafer	김성준	포항공과대학교
PB-20	Ohmic Contact Formation at Low Temperature Using Ni-Based Metal Alloy on n-Type 4H-SiC	김성준	포항공과대학교
PB-21	Investigation of Redox Potential Change on 4H-SiC Surfaces in Various Treatment for Sensor Applications	김성준	포항공과대학교
PB-22	SiC Double Trench MOSFET 공정을 위한 Gate 공정 최적화	이수진	포항공과대학교
PB-23	고내압 4H-SiC MOSFET에 적용되는 Field-ring 기술에 관한 고찰	김대희	극동대학교
PB-24	기반 물질 차이에 따른 SBD 구조의 특성 변화에 대한 고찰	최진혁	극동대학교
PB-25	"Annealing Dependent Electrical Characteristics of (Al _x Ga _{1-x}) ₂ O ₃ /4H-SiC Photodetectors"	신명철	광운대학교
PB-26	Static Characteristics of 3.3 kV 4H-SiC Super Junction MOSFETs	김동현	광운대학교
PB-27	Bandgap Engineering in (Al _x Ga _{1-x}) ₂ O ₃ /4H-SiC Heterostructures	이희재	광운대학교
PB-28	Optimization of Switching Characteristics of 4.5 kV-Class 4H-SiC Super Junction MOSFET Devices	정승우	광운대학교
PB-29	내장형 커패시터로 응용하기 위해 상온 분말 분사 공정으로 제작된 BaTiO ₃ /Cu 복합체 필름의 Cu 분말 입자 크기에 따른 유전 및 전기적 특성 분석	전좌빈	광운대학교
PB-30	유한요소법을 이용한 SiC 쇼트키 베리어 다이오드의 단자 강도 시험	최나연	동의대학교
PB-31	A Study on Package of Full SiC Power Module	장창리	Shenzhen HuaSemi Electronics Co Ltd
PB-32	고온 및 높은 게이트 전압에서 4H-SiC MOSFET의 열화특성 분석	강인호	한국전기연구원
PB-33	Ag coated Cu분말을 이용한 소결접합용 페이스트 개발	원미소	한국전자기술연구원